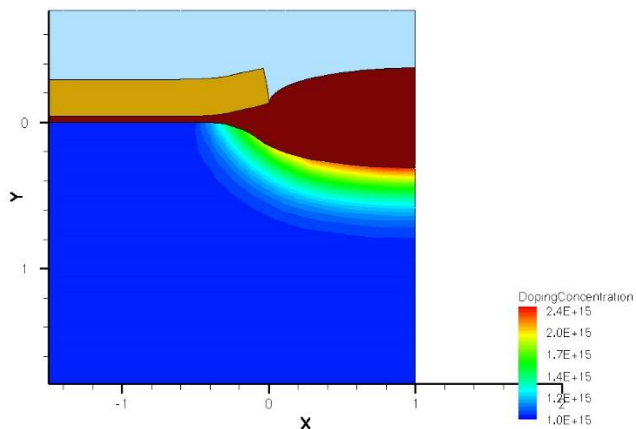
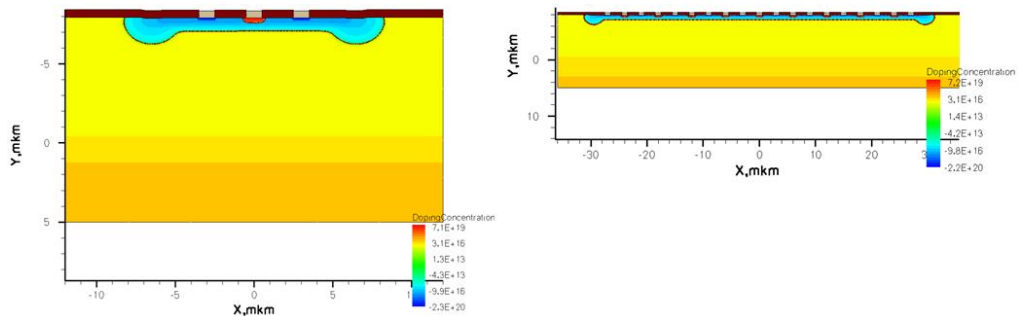


**«Центр проектирования» НПП «Пульсар» обладает компетенциями в области разработки, проектирования и оптимизации полупроводниковых приборов и элементов ИМС, а также технологии их изготовления на основе наиболее распространённых полупроводниковых материалов Si, Ge, SiGe, GaAs, GaN.**

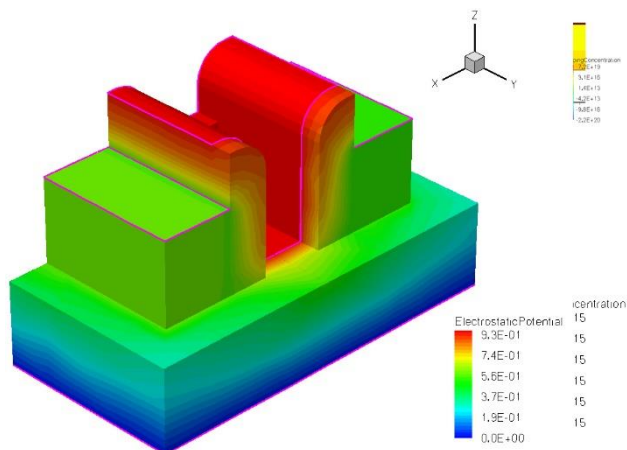
1. Расчёт параметров процессов диффузии, имплантации, окисления, осаждения, травления



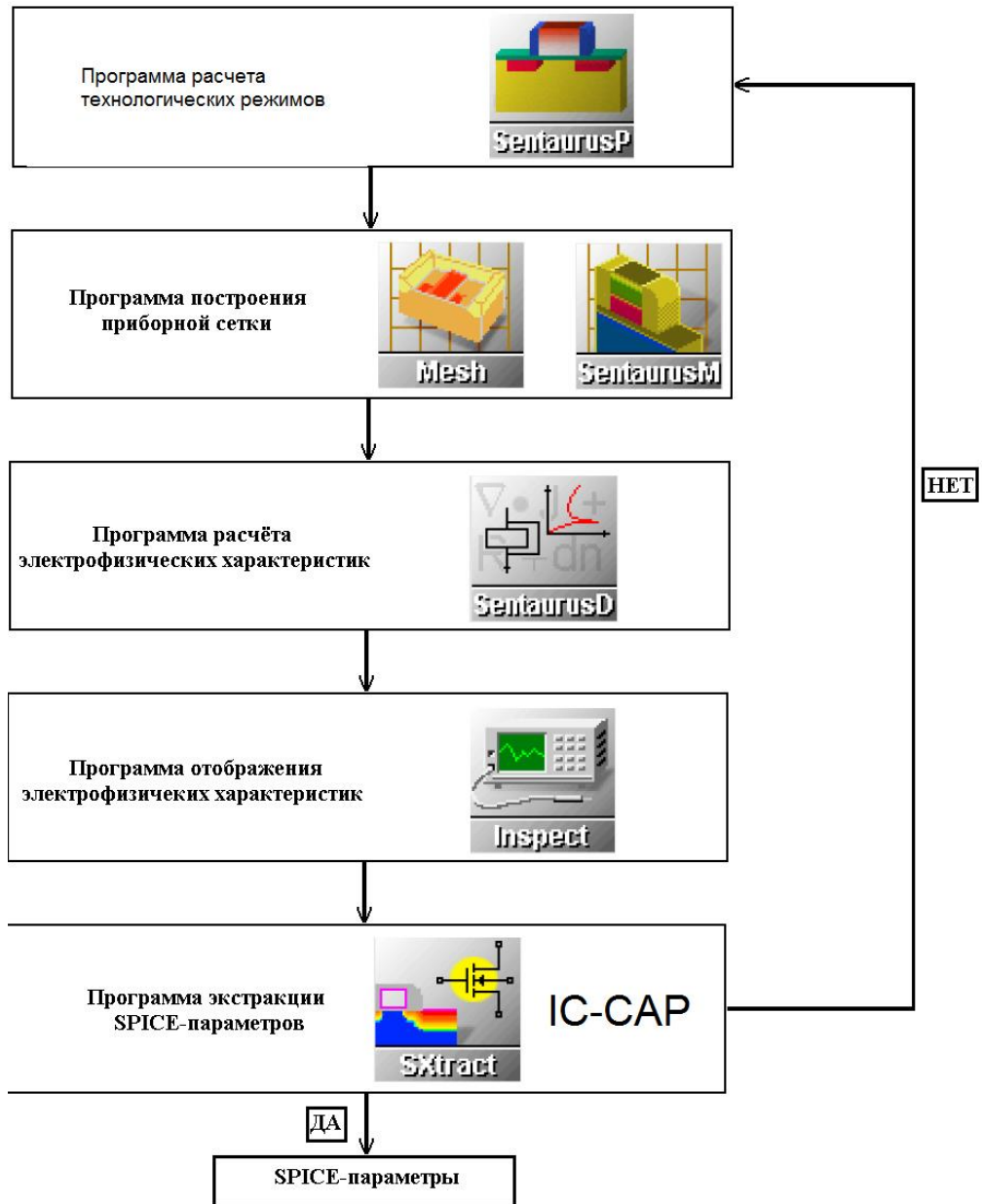
2. Оптимизация топологических размеров элементов ИМС



3. Расчёт статических и динамических характеристик полупроводниковых приборов различного типа



4. Экстракция параметров моделей разрабатываемых транзисторов



5. Разработка подходов к моделированию физических процессов, происходящих в приборах